



(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A2)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 54

(51) Int Cl.:
C23C 18/12 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
04.04.2012 Patentblatt 2012/14

(43) Veröffentlichungstag:
08.02.2012 Patentblatt 2012/06

(21) Anmeldenummer: **11075187.2**

(22) Anmeldetag: **02.08.2011**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(72) Erfinder:
• **Latzel, Björn**
12167 Berlin (DE)
• **Belaïdi, Abdelhak**
10589 Berlin (DE)
• **Schwarzburg, Klaus**
12209 Berlin (DE)

(30) Priorität: **03.08.2010 DE 102010033198**

(71) Anmelder: **Helmholtz-Zentrum Berlin für**
Materialien
und Energie GmbH
14109 Berlin (DE)

(54) **Verfahren zur Herstellung einer nanokristallinen CuSCN-Schicht auf einem Substrat**

(57) Bei dem Verfahren zur Herstellung einer dünnen nanokristallinen CuSCN-Schicht auf einem Substrat mittels chemischer Badabscheidung wird erfindungsgemäß zunächst eine Substratvorbehandlung zur Aktivierung der Oberfläche durchgeführt und anschließend das Sub-

strat und die wässrige Lösung auf unterschiedliche Temperaturen eingestellt, wobei die Temperatur des Substrats höher eingestellt wird als die Temperatur der Lösung, und eine wässrige Lösung mit 0,1 bis 200 mM Cu (II)- und SCN-Ionen verwendet wird.

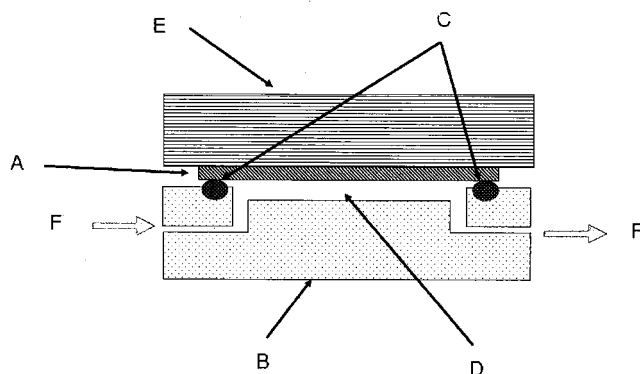


Fig. 1